

2SB524

低周波電力増幅用
シリコンPNPエピタキシャルプレーナ形

概 要

2SB524は、シリコン樹脂封止形のシリコンPNPエピタキシャルプレーナ形パワートランジスタで、5~10W出力のホームステレオ等の出力用として、2SD361とコンプリメンタリで使用するのに最適です。

特 長

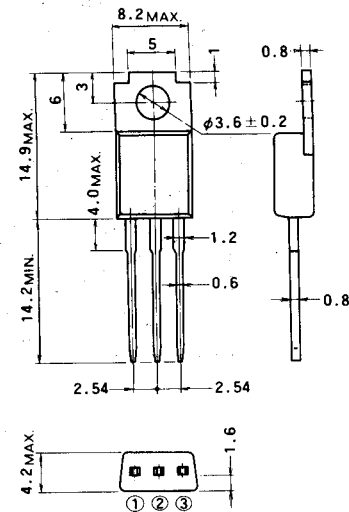
- 耐圧が高い $V_{CE0} \geq -40V$
- 大電流での h_{FE} の低下が少ない
- コレクタ電流が大きい $I_C = -1.5A$ 、 $I_{CM} = -3A$
- $V_{CE(sat)}$ が低い $I_C = -1A$ で $-1V$ 以下

用 途

ホームステレオ等の5~10W出力の低周波電力増幅回路

外形図

単位: mm



電極接続

- ①: ベース EIAJ: -
②: コレクタ (放熱板) JEDEC: -
③: エミッタ

(注1) 公差指定のない寸法は代表値を示す。

最大定格 ($T_0 = 25^\circ C$)

記 号	項 目		定 格 値	単 位
V _{CB0}	コレクタ・ベース間電圧		-60	V
V _{EB0}	エミッタ・ベース間電圧		-5	V
V _{CE0}	コレクタ・エミッタ間電圧		-40	V
I _C	コレクタ電流		-1.5	A
I _{CM}	せん頭コレクタ電流		-3	A
P _C	コレクタ損失	T _a =25℃	1	W
P _C		T _O =25℃	10	W
T _j	接合部温度		150	℃
T _{stg}	保存温度		-55～+150	℃

電気的特性 ($T_0 = 25^\circ C$)

記 号	項 目	測 定 条 件	特 性 値			単 位
			最 小	標 準	最 大	
$V_{(BR)CBO}$	コレクタ・ベース降伏電圧	$I_C = -1mA$, $I_E = 0$	-60			V
$V_{(BR)EBO}$	エミッタ・ベース降伏電圧	$I_E = -1mA$, $I_C = 0$	-5			V
$V_{(BR)CEO}$	コレクタ・エミッタ降伏電圧	$I_C = -10mA$, $R_{BE} = \infty$	-40			V
I_{CBO}	コレクタしゃ断電流	$V_{CB} = -25V$, $I_E = 0$			-1	μA
I_{EBO}	エミッタしゃ断電流	$V_{EB} = -5V$, $I_C = 0$			-1	μA
$h_{FE} \uparrow$	直流電流増幅率	$V_{CE} = -4V$, $I_C = -0.5A$, パルス測定	55	110	300	—
$V_{CE(sat)}$	コレクタ・エミッタ飽和電圧	$I_C = -1A$, $I_B = -0.05A$			-1	V
V_{BE}	ベース・エミッタ間電圧	$V_{CE} = -4V$, $I_C = -0.05A$		-0.7		V

†: h_{FE} の値により右表のようにアイテム分類を行っています。

アイテム	C	D	E
h_{FE}	55~110	90~180	150~300